

مجلہ سنجش و ایمنی پرتو سنجی

مجله سنجش و ايمني پرتو، جلد ٦، شمارهٔ ٢، بهار ١٣٩٧

محاسبهی ضرایب انباشت چشمهی گاما با طیف انرژی پیوسته برای آب، آهن و سرب بهوسیلهی کد مونت کارلو

مصطفى محمدرفيعى* و حسين توكلىعنبران

دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران. *سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، کد پستی: ۹۵۱۶۱–۹۳۱۹۹ پست الکترونیکی: mustafa.m.rafiei@gmail.com

چکیدہ

ضریب انباشت عامل مهمی در تعیین ضخامت حفاظ پرتوهای گاما و ایکس میباشد به نحوی که بدون در نظر گرفتن این ضریب ضخامت حفاظ کم تر از آن چیزی که مورد انتظار است، اندازه گیری شده و منجر به خطرات پرتو گیری بیش از حد کارکنان و یا بیماران میشود. با توجه به اینکه ضریب انباشت برای چشمههای نقطهای همگن تک انرژی محاسبه شده است اما محاسبهی این ضریب برای چشمههایی با طیف انرژی پیوسته از طریق کد مونت کارلو MCNPX تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه سعی بر این است که تفاوت ضریب انباشت ناشی از چشمهای با طیف انرژی پیوسته در مقایسه با چشمهای تک انرژی بررسی شود. بنابراین ضریب انباشت پرتوگیری چشمهای با طیف انرژی پیوسته با انرژی بیشینهی ۱ مگا الکترونولت (یک طیف انرژی نمونه) با چشمهای تک انرژی با انرژی ۱ انبات پرتوگیری چشمهای با طیف آهن و سرب تا ۱۰ مسیر آزاد میانگین مورد محاسبه قرار گرفته و تفاوت چشمگیری در مقادیر بهدست آمده مشاهده شده است. به نحوی که اختلاف نسبی بین ضریب انباشت پرتوگیری ناشی از چشمهی تک انرژی و چشمهای با طیف انرژی پیوسته به ازای ۱ تا ۱۰ مسیر آزاد میانگین اختلاف نسبی بین ضریب انباشت برتوگیری ناشی از چشمهی تک انرژی و چشمهای با طیف انرژی پیوسته به ازای ۱ تا ۱۰ مسیر آزاد میانگین مریب از ای میشی می از ای می میزی است. در مقاسه با پر این ای تان ۲۰ و برای میه ازرژی پیوسته به ازای ۱ تا ۱۰ مسیر آوین و سرب تا ۱۰ مسیر آزاد میانگین مورد محاسبه قرار گرفته و تفاوت چشمگیری در مقادیر بهدست آمده مشاهده شده است. به نحوی که اختلاف نسبی بین ضریب انباشت پرتوگیری ناشی از چشمه ی تک انرژی و چشمهای با طیف انرژی پیوسته به ازای ۱ تا ۱۰ مسیر آزاد میانگین مرای آب به ترتیب از ۳۸٪ تا ۲۰۳۸، برای آهن به ترتیب از ۲۰۷۰ تا ۲۰۰۰ و برای سرب به ترتیب از ۲۰۸ تا ۲۰۰ است. بر همین اساس در راستای

کلید واژگان: ضریب انباشت پرتوگیری، طیف انرژی پیوسته، کد MCNPX، تکنیک کاهش واریانس، تکثیر ذرات.

۱. مقدمه

بسیار اهمیت دارد به نحوی که یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در تعیین حفاظ با ضخامت مناسب ضریب انباشت میباشد. ضریب انباشت نسبت کمیت مورد نظر ناشی از تعداد کل فوتونها در یک نقطه به کمیت مورد نظر ناشی از فقط حفاظ گذاری پرتوی ایکس و گاما از مسائل بسیار مهم در نجات و حفظ بافتهای زنده است. در مسائل حفاظ گذاری برای پرتوهای فوتون یونساز، از جمله پرتو ایکس و گاما، تعیین مادهی حفاظ مناسب و همچنین ضخامت دقیق آن ماده

فوتونهای پراکنده نشده در همان نقطه تعریف می شود [۱و۲]. این کمیت مورد نظر می تواند تعداد ذرات، انرژی ذخیره شده در محیط و یا دز تابشی باشد. برهمین اساس ضرایب انباشت متفاوتی تعریف می شوند از جمله ضریب انباشت تعداد ذرات، ضریب انباشت پر توگیری و ضریب انباشت دز.

از نقطه نظر تاریخی ضریب انباشت ابتدا در سال ۱۹۵٤ میلادی محاسبه شد [۳] و پس از آن تحقیقات گستردهای در خصوص چگونگی و نحوهی محاسبهی این ضریب توسط محققان آغاز شد و نتیجهی آن مطالعات، تهیهی یک استاندارد بین المللی در کشور امریکا به نام (ANSI/ANS-6.4.3) است [٤]. البته امروزه این استاندارد به علت نقاط ضعفی که در داده-های سطح مقطع داشت از رده خارج شده است اما همچنان بهعنوان یک منبع نسبتاً خوب برای مقایسهی نتایج محاسبات مربوط به ضریب انباشت مورد استفاده قرار می گیرد. البته برای بهبود محاسبات مربوط به ضريب انباشت اين استاندارد، كار-های متعددی انجام شده است [٥و٦]. در بسیاری از تحقیقات گذشته ضریب انباشت برای یک چشمهی نقطهای همگن تک انرژی پرتوی گاما مورد مطالعه قرار گرفته است [۷–۱۰]. اما تمام چشمههای پرتو گاما تک انرژی نیستند و ممکن است با طيف انرژی پيوسته سرکار داشته باشيم از جمله در پژوهش های مربوط به طراحی چشمهی فوتونوترون با استفاده از الکترونهای شتابدهندهی خطی، فوتونهایی با طیف انرژی پیوسته احتیاج است [۱۱و۱۲و۱۳]. این فوتونها در اثر برخورد الکترونهای پر انرژیی که از شتابدهنده خارج شده و به یک هدف با عدد اتمي بالا مانند تنگستن برخورد ميكنند، بهوجود میآیند (که به این فرآیند تابش برمشترالانگ گفته میشود) و در نهایت این فوتونها با برخورد به هدفهایی به نام هدف فوتونوترون مانند برليوم و دوتريوم منجر به توليد شار نوترون می شوند. در این صورت ضرایب انباشت محاسبه شده برای چشمههای گامای تک انرژی به منظور تعیین ضخامت مناسب

حفاظ به کار نمی آیند. در این پژوهش سعی شده است تا ضرایب انباشت پرتوگیری برای یک چشمهی نقطهای همگن با طیف انرژی پیوسته (یک طیف نمونه با بیشینه انرژی ۱ مگا الکترونولت) به وسیله ی کد 2.6 MCNPX [٤1] برای حفاظ آب، آهن و سرب تا عمق ۱۰ مسیر آزاد میانگین محاسبه شود. همچنین مقایسهای بین ضرایب انباشت ناشی از چشمه ی پیوسته ی ذکر شده و چشمه ی تک انرژی ۱ مگا الکترون ولت ناجام شده است که در این مقایسه تفاوت چشمگیری در منظور اعتبار سنجی محاسبات ضرایب انباشت پرتوگیری برای منظور اعتبار سنجی محاسبات ضرایب انباشت پرتوگیری برای نتایج آن با کار دیگران مقایسه شده است که در این مقایسه همخوانی قابل قبولی برای تمامی مواد حفاظ به کار گرفته شده در این کار مشاهده می شود.

۲. تئورى

همانطور که میدانید نفوذ پرتوهای گاما از رابطهی نمایی ذیل پیروی میکند [۱و۱۵].

$$\varphi = B(E, \mu x) \varphi_0 \exp(-\mu x) \tag{1}$$

که $\varphi \in \varphi_0$ به ترتیب شار کل و شار اولیه فوتونها می باشند، B ضریب انباشت، E انرژی فوتونها برحسب مگاالکترون-ولت، μ ضریب تضعیف خطی کل برحسب¹-x، cm ضخامت برحسب cm می باشد. در این صورت ضریب انباشت تابعی همزمان از انرژی فوتونها و فاصلهی پیموده شده برحسب مسافت آزاد میانگین آنها در ماده می باشد. می توان فاصلهی پیموده شده را بر حسب مسافت آزاد میانگین به صورت زیر نوشت:

 $mfp = \mu x \tag{7}$

$$B_{E}(E_{0},r) = \frac{\int_{0}^{E_{\max}} \varphi(r,E) E \ \mu_{a}^{air}(E) dE}{\int_{0}^{E_{\max}} \varphi_{u}(r,E) E \ \mu_{a}^{air}(E) dE}$$
(7)

به دلیل اینکه کد MCNPX شار گسستهای از کل فوتونها و همچنین فوتونهای ناپراکنده در اختیار کاربر قرار میدهد رابطهی ٦ باید بهصورت زیر بازنویسی شود تا بتوان ضریب انباشت پرتوگیری ناشی از یک طیف پیوسته ی پرتوی گاما را محاسبه کرد.

$$B_{E} = \frac{\sum_{g=1}^{G} \varphi_{g} \times \overline{E}_{g} \times \mu_{a}^{air}(\overline{E}_{g})}{\sum_{g=1}^{G} \varphi_{ug} \times \overline{E}_{ug} \times \mu_{a}^{air}(\overline{E}_{ug})}$$
(V)

که G تعداد گروههای انرژی، $\varphi_g \ e_{gg}$ بهترتیب شار کل و شار فوتونهای ناپراکنده با انرژی بین $E_{g} \ e_{g}$ میباشد. $\overline{E}_{g} \ e_{gg}$ انرژی میانگین گروه شار فوتونهای کل و ناپراکنده میباشد. در نهایت به منظور محاسبهی خطای انتشار یافتهی ضریب انباشت پرتوگیری، رابطهی گسترش خطا براساس رابطهی ۷ به صورت زیر نوشته میشود.

$$\sigma_{B_E}^2 = \left(\frac{\partial B_E}{\partial \varphi_g}\right)^2 \sigma_{\varphi_g}^2 + \left(\frac{\partial B_E}{\partial \varphi_{ug}}\right)^2 \sigma_{\varphi_{ug}}^2 \tag{A}$$

که σ_{arphi_g} و $\sigma_{arphi_{ug}}$ بهترتیب خطای ضریب انباشت، خطای σ_{arphi_g} , $\sigma_{ar{B}_E}$ که $arphi_g$ و $arphi_{ug}$ میباشد.

۳. روش انجام کار

در این تحقیق برای محاسبهی ضریب انباشت پرتوگیری ناشی از چشمهی نقطهای تک انرژی و چشمهی نقطهای با طیف انرژی پیوسته بهترتیب از روابط ٤ و ۷ بههمراه تالی F2 استفاده شده و برای یافتن شار پرتوهای فوتونی که بدون برخورد از محیط عبور میکنند از کارتهای FT، FU، C و E ضریب تضعیف خطی کل، کمیتی است که از ماده ای به ماده ی دیگر تفاوت می کند. این ضریب شامل ۱۲ نوع برهمکنش متفاوت است [۱٦] که در این جا به صورت حاصل جمع ٤ نوع برهمکنش غالب در نظر گرفته شده است.

$$\mu = \mu_{pe} + \mu_{coh} + \mu_{incoh} + \mu_{pair} \tag{(7)}$$

که μ_{oh} , μ_{coh} , μ

$$B_{E}(E_{0},r) = \frac{\int_{0}^{E_{0}} \varphi(r,E) E \ \mu_{a}^{air}(E) dE}{\varphi_{0} \exp(-\mu r) \mu_{a}^{air}(E_{0}) E_{0}}$$
(£)

که μ_a^{air} ضریب جذب خطی هوا بر حسب cm^{-1} میباشد. در اینصورت شار فوتونهای پراکنده نشده (φ_u) را نیز میتوان بهصورت زیر نوشت.

$$\varphi_u = \varphi_0 \exp(-\mu r) = \left(\frac{S}{4\pi r^2}\right) \exp(-\mu r) \qquad (\circ)$$

که S قدرت چشمه بر حسب فوتون بر ثانیه می باشد. چون در این مطالعه هدف تحقیق محاسبهی ضریب انباشت پرتوگیری برای چشمهای با طیف انرژی پیوسته (از انرژی صفر تا انرژی بیشینهی IMeV = E_{max} همانطور که در شکل ۱ ملاحظه می شود) است، پس باید رابطهی ٤ را به صورت زیر بازنویسی کرد.







شکل (۲): هندسهی حفاظ آب و چشمهی نقطهای گاما (در مرکز کره) را نشان میدهد که شعاع کرهی آب براساس مسافت آزاد میانگین (mfp) پرتوهای گاما تعیین می شود.

جدول (۱): ضریب تضعیف خطی کل آب، آهن و سرب به ازای انرژی ۱ مگاالکترونولت [۱۸] و فاصلهی پیموده شدهی متناظر برای ۱ مسیر

ميانگين.	زاد

فاصلهی پیموده شده (cm)	ضریب تضعیف خطی کل (cm ⁻¹)	نوع مادہ
12/17077	•/•٧•٥٩	آب
7/1122	•/EVT•E7٣	آهن
١/٢٤٠٥٨	•/A•J•VV	سرب

در جدولهای ۲، ۳ و ٤ ضرایب انباشت پرتوگیری محاسبه شده براساس طیف انرژی شکل ۱، بهترتیب برای آب، آهن و سرب ملاحظه می شوند. در این جدول ها ضرایب انباشت برای

استفاده شده است. همانطور که در شکل ۲ ملاحظه می شود برای انجام محاسبات مربوط به ضریب انباشت مواد حفاظ (آب، آهن و سرب) به صورت کرههایی با شعاعهای مشخص (فاصلهی پیموده شده برحسب مسافت آزاد میانگین) در نظر گرفته شدهاند به صورتی که تالی F2 روی سطح این کرهها، شار کل فوتونها و شار فوتونهایی که بدون برخورد از مادهی حفاظ عبور کردهاند را محاسبه میکند. همچنین در این بررسی به منظور اعتبارسنجی محاسبات، ضریب انباشت پرتوگیری برای یک چشمهی تک انرژی ۱ مگاالکترونولت محاسبه شده و نتایج أن با كار دیگران [٤و٥] مقایسه و توافق خوبی مشاهده شده است. داده های سطح مقطع مورد استفاده در این محاسبات برای ضریب تضعیف خطی کل آب، آهن و سرب، و ضریب جذب خطى هوا به ترتيب از ENDF/B-VI [18] و NIST-XCOM [۱۸] استخراج شده است. همچنین باید متذکر شد که استفاده از کدهای هستهای که بر مبنای روش مونت کارلو بصورت آنالوگ (بدون استفاده از روشهای کاهش واریانس) برای محاسبات مربوط به ضریب انباشت کار میکنند برای رسیدن به خطای مطلوب و قابل اطمینان زمان بسیار زیادی را از كاربر می گیرند. تنها راه نجات از این وضعیت ناگوار استفاده صحیح از روشهای کاهش واریانس میباشد. روش کاهش واریانسی که در اینگونه مسائل بسیار مؤثر عمل کرده است روش كاهش واريانس تكثير ذرات (Particle Splitting) مي-باشد [۱۹و۲۰] که در این کار نیز از همین روش کاهش واریانس استفاده شده است. در همین راستا در شکل ۱ میتوان طیف انرژی پیوسته چشمهی مورد نظر برای محاسبهی ضریب انباشت پرتوگیری را ملاحظه کرد. این طیف انرژی بهعنوان یک طیف انرژی نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. برای یکسان بودن شرایط مسئله طول ۱ مسیر آزاد میانگین متناظر با انرژی ۱ مگاالکترونولت براساس دادههای ضریب تضعیف خطی کل آب، آهن و سرب در جدول ۱ آورده شدهاند.

حفاظ آب، آهن و سرب تا عمق ۱۰ مسیر آزاد میانگین هم برای طیف پیوسته ی شکل ۱ و هم برای چشمه ی تک انرژی ۱ مگاالکترون ولت محاسبه شدهاند. همچنین به منظور اعتبار سنجی، محاسبات مربوط به چشمه ی تک انرژی با کار دیگران [٤و٥] مقایسه شده که هم خوانی خوبی را نشان می-دهند. خطای ضریب انباشت پر توگیری بر اساس رابطه ی انتشار خطا محاسبه شده که بیشینه خطا در این محاسبات کم تر از ۱ درصد می باشد و مقادیر خطای انتشار یافته برای ضرایب انباشت پر توگیری در جداول ذکر شده است.

دلیل اصلی بهوجود آمدن چنین اختلاف چشمگیری بین ضرایب انباشت پرتوگیری محاسبه شده از یک چشمهی تک انرژی گاما با ضرایب انباشت پرتوگیری محاسبه شده از یک چشمهی پیوستهی گاما این است که ضریب تضعیف جرمی کل مواد (از جمله آب، آهن و سرب) و همچنین ضریب جذب جرمی هوا به شدت به انرژی فوتونها وابسته هستند.

جدول (۲): ضرایب انباشت پرتوگیری برای آب براساس طیف انرژی شکل ۱ و مقایسه با ضرایب انباشت چشمهی تک انرژی ۱ مگاالکترون-

		ولت [٤و٥].		
		کار حاضر، چشمهی	کار حاضر، چشمه	
مرجع	مرجع	تک انرژی ۱ مگا	با طيف پيوسته	mfp
[2]	[0]	الكترونولت	براساس شكل ۱	
۲/•۸	۲/•۸	$\gamma/\cdot \neg \cdot \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot \cdot \gamma$	Y/λ o·· \pm ·/··· λ	١
٣/٦٢	٣/٦٣	$r/r \cdots \pm r/r$	$0/29. \pm ./7$	۲
0/0 •	0/0٣	$0/0$ $\cdots \pm \cdot/\cdots$ π	$\Lambda/00.\pm./$	٣
٧/٦٨	V/VY	$V/V $ $\xi \cdot \cdot \pm \cdot / \cdot \cdot \cdot 0$	۱۱/۹۰۰ ± ۰/۰۰ ٤	٤
۱•/۱	۱ • / ۲	$1 \cdot / 1 \cdot \cdot \pm \cdot / \cdot \cdot \cdot \vee$	$10/2V \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot 0$	٥
١٢/٨	١٢/٩	17/90 ± ./9	$19/1.1 \pm 1/1.1$	٦
۱٥/٨	۱٥/٩	$10/90. \pm ./1$	۲۳/۳۱ ± ۰/۰۱	٧
۱٩/۰	19/1	$19/71 \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot 7$	$V/07 \pm \cdot/\cdot 1$	٨
۲٦/١	777	TVEV. ± ./T	۳٦/٧٤ ± ٠/٠٢	۱۰

جدول (۳): ضرایب انباشت پرتوگیری برای آهن براساس طیف انرژی شکل ۱ و مقایسه با ضرایب انباشت چشمهی تک انرژی ۱ مگاالکترون-ولت [٤و٥].

		کار حاضر، چشمهی	کار حاضر، چشمه	
مرجع	مرجع	تک انرژی ۱ مگا	با طيف پيوسته	mfp
[٤]	[0]	الكترونولت	براساس شکل ۱	-
١/٨٥	١/٨٨	$1/\sqrt{1} \cdot \cdot \pm \cdot / \cdot \cdot \cdot \sqrt{1}$	7/1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	١
۲/۸٥	۲/۸۹	$1/1000 \pm 1/1000$	$r/or \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot r$	۲
٤/••	٤/٠٥	$\epsilon/\cdot \cdot \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot \cdot$	o/. T. \pm ./ 2	٣
٥/٣٠	٥/٣٥	$0/1.1 \cdot \pm \cdot/ \cdot \cdot 1$	$\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$	٤
٦/٧٤	٦/٨٠	٦/٧٦٠ \pm ٠/٠٠٣	$h/{\rm Tr} \cdot \pm \cdot/{\rm r} \cdot h$	٥
Λ/T^{\prime})	$\Lambda/ {\tt T} \Lambda$	۸/۳٦• \pm •/••٤	$1 \cdot 1 1 1 \pm 1 1 1$	٦
۱۰/۰	۱•/۱	$\mathbf{)} \cdot / \cdot \mathbf{\ddot{v}} \pm \cdot / \cdot \cdot \mathbf{o}$	۱۲/۹·± •/۰۱	v
۱۱/۸	۱۱/۹	$11/10. \pm ./V$	$10/10 \pm \cdot/\cdot 1$	٨
۱٥/٨	۱٥/٩	$10/V0 \pm \cdot/\cdot 1$	۲۰/٤٣ ± ۰/۰۲	١٠

جدول (٤): ضرایب انباشت پرتوگیری برای سرب براساس طیف انرژی شکل ۱ و مقایسه با ضرایب انباشت چشمهی تک انرژی ۱ مگاالکترون-

ولت [٤و٥].

		کار حاضر، چشمه-	کار حاضر، چشمه	
مرجع	مرجع	ی تک انرژی ۱ مگا	با طيف پيوسته	mfp
[٤] [٥]	الكترون ولت	براساس شکل ۱		
١/٣٨	١/٣٧	$1/2 \cdots \pm \cdot/\cdots $	$1/\xi \wedge \cdot \cdot \pm \cdot / \cdot \cdot \cdot q$	١
1/71	1/7V	$1/\sqrt{1} \cdot \cdot \cdot \pm \cdot / \cdot \cdot \cdot \circ$	$1/AV \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot 1$	۲
1/90	1/90	$1/40\pm$	۲/۲٥۰ ± •/۰۰۲	٣
۲/۱۹	۲/۲.	$Y/Y \cdots \pm \cdot/\cdots \wedge$	۲/٦٤·± •/••٢	٤
۲/٤٣	٢/٤٤	7/28. ± •/••1	۳/۰۳۰ ± ۰/۰۰۲	٥
۲/٦٦	۲/٦٧	$7/77. \pm ./)$	۳/٤٣٠ ± ٠/٠٠٣	٦
۲/۸۹	۲/٩.	$1/\Lambda \cdot \pm \cdot/\cdot \cdot 1$	γ/λ o·±·/·· γ	v
٣/١٠	۳/۱۱	$\gamma \cdots \gamma \cdots \gamma$	٤/٢٩٠ ± •/••٤	٨
۳/۵۱	٣/٥٢	r/2 · · · · r	0/Y1•±•/••0	۱.

این وابستگی را در محاسبهی ضریب انباشت پرتوگیری در روابط ٤ و ٦ نشان داده شده است و ضرایب جذب جرمی هوا که در این محاسبات استفاده شدهاند را می توانید در جدول ٥ جلد ششم، شماره ۲

مشاهده کنید. بر این اساس انتظار میرود که ضرایب انباشت محاسبه شده ناشی از چشمهای با طیف انرژی پیوسته در مقایسه با ضرایب انباشت ناشی از چشمهی تک انرژی متفاوت باشند.

جدول (٥): ضرایب جذب جرمی هوا [۱۸].

ضريب جذب جرمي	اندژی (MeV)	
(cm^2/g)		
8099	•/••1	
1144	•/•10	
٥٢٦/٢	•/••٢	
171/2	•/••٣	
V7/77	•/••£	
٣٩/٣١	•/••0	
¥ ¥/V•	•/••٦	
٩/٤٤٦	•/••٨	
٤/٧٤٢	•/•)	
1/272	•/•10	
•/0٣٨٩	•/• ٢	
•/10TV	•/•٣	
•/• 7/77	•/•٤	
•/•٤•٩٨	•/•0	
•/•٣•٤١	•/•٦	
•/•YE•V	•/•A	
•/• ٣٣٢ ٥	• / \	
•/• 7 £ 9 7	•/10	
•/• ٢٦٧٢	•/٢	
•/• 7/17	•/٣	
•/• ٢٩٤٩	• / ٤	
•/•٢٩٦٦	• / 0	
•/• 2902	•/٦	
•/• 7//7	•/٨	
•/• ٢٧٨٩	١	







انرژی (مربع توپر).

For monoenergetic 5 For continuous energy Exposure Buildup Factor 4 3 -2 -\$ 1 + 2 8 10 4 6 شکل (٥): ضرایب انباشت پرتوگیری محاسبه شده در کار حاضر برای سرب به ازای چشمهی با طیف پیوسته (مثلث توپر) و برای چشمهی تک انرژی (مربع توپر).

٤. بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش محاسبهی ضریب انباشت پرتوگیری برای یک چشمه با طیف انرژی پیوسته (یک طیف انرژی نمونه بر اساس شکل ۱) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی به منظور اعتبار سنجی محاسبات، ضریب انباشت پرتوگیری برای یک چشمهی تک انرژی محاسبه شده و نتایج آن با کار دیگران [٤و] مقایسه و توافق خوبی مشاهده شد. البته در کار حاضر نتایج محاسبات برای چشمهی تک انرژی ۱ مگاالکترونولت تطبیق بسیار بهتری نسبت به کار انجام شده در مرجع ۱۰ دارد و برای انجام محاسبات از روش مونت کارلو براساس کد مونت كارلو MCNPX بهره گرفته شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در مواردی ممکن است ضرایب انباشت برای چشمههای تک انرژی که توسط دیگران محاسبه شده تفاوتهای اندکی با یکدیگر داشته باشند این تفاوتها به دو دلیل رخ میدهند، دلیل اول: تفاوت در سطح مقاطع فوتونی مورد استفاده میباشد چون هرچه زمان میگذرد آزمایشها و روشهای محاسبهی سطح مقاطع بهتر، کاملتر و دقیقتر می-شوند. سطح مقاطعی که در این کار استفاده شده است همانطور که در متن مقاله به آنها اشاره شده است، سطح مقاطع بهروزی

هستند پس بنابراین، اینکه از چه سطح مقاطعی از لحاظ بهروز بودن و دقیق بودن استفاده شود، تأثیر چشمگیری بر محاسبهی دقيق ضريب انباشت خواهد داشت كه خود اين مسئله منجر به تفاوت در مقادیر محاسبه شده توسط محققان مختلف می شود. دلیل دوم: امروزه ضریب انباشت به روشهای متفاوتی محاسبه می شود، بطور مثال: Invariant embedding [٥و٨و٩] ، G-P fitting [٥و٨و٩] و غيره. بنابراین تفاوت در این روشها نیز می تواند منجر به تفاوت در محاسبهي ضرايب انباشت شود بنابراين براساس نتايج بهدست آمده در جداول ۲، ۳ و ٤ نتیجه می شود که ضرایب انباشت پرتوگیری برای یک چشمه با طیف انرژی پیوسته در مقایسه با یک چشمه تک انرژی با شرایط یکسان از نظر نوع ماده حفاظ و همین طور ضخامت حفاظ، تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. بر اساس آنچه که در بخش قبل گفته شد، دلیل اصلی بهوجود آمدن چنین اختلاف چشمگیری تنها وابستگی ضرایب تضعیف و جذب فوتونها در مواد به انرژی فوتونها میباشد و زمانی که ضرایب انباشت برای یک طیف پیوسته محاسبه می شود هر کدام از فوتون ها انرژی متفاوتی دارند بنابراین نحوهی تضعیف و یا جذبشان در مواد مختلف، متفاوت خواهد بود. بنابراین، این تفاوت معنادار باید در محاسبهی ضخامت حفاظ به منظور حفظ سلامت کارکنان و یا بیماران در نظر گرفته شود. همچنین این پژوهش نشان میدهد که کد مونت كارلو MCNPX بەخوبى توانايى محاسبەي ضرايب انباشت پرتوگیری، هم ناشی از چشمههای گامای تک انرژی و هم چشمههای گاما با طیف انرژی پیوسته را دارا میباشد.

در اینجا خوب است که ذکر شود در یک کار پژوهشی دیگر، توانایی کد MCNPX در محاسبهی ضرایب انباشت پرتوگیری برای فوتونهایی با انرژی ٥ و ١٠ مگاالکترونولت مورد بررسی قرار گرفته است که طی این بررسیها نتایج مطلوبی حاصل شده است. [٢٢].

٥. مراجع

- N. Tsoulfanidis, S. Landsberger. Measurement & Detection of Radiation. CRC Press, New York, (2015).
- [2] H. Cember, T.E. Johnson. Introduction to Health Physics. McGraw-Hill, New York, (2009).
- [3] H. Goldstien, J.E. Wilkins. Calculations of the Penetration of Gamma Rays: Final Report. Nuclear Development Associates, Tenn, (1954).
- [4] ANSI/ANS-6.4.3. American National Standard gamma-ray attenuation. (1991).
- [5] A. Shimizu, T. Onda, Y. Sakamoto. Calculation of Gamma-Ray Buildup Factors up to Depths of 100 mfp by the Method of Invariant Embedding, (III). J .Nucl. Sci. Technol. 4 (2004) 413–424.
- [6] C.E. Sanders. Development of Buildup Factors for Updating the ANSI/ANS-6.4.3 Standard. Proceedings of the 18th International Conference on Nuclear Engineering, (2010).
- [7] A.B. Chilton, C.M. Eisenhauer and G.L. Simmons. Photon Point Source Buildup Factors for Air, Water, and Iron. Nucl. Sci. Eng. 1 (1980) 97–107.
- [8] A. Shimizu, T. Onda, Y. Sakamoto. Calculation of Gamma-Ray Buildup Factors up to Depths of 100 mfp by the Method of Invariant Embedding, (I). J .Nucl. Sci. Technol. 4 (2004) 413–424.
- [9] A. Shimizu, T. Onda, Y. Sakamoto. Calculation of Gamma-Ray Buildup Factors up to Depths of 100 mfp by the Method of Invariant Embedding, (II). J .Nucl. Sci. Technol. 4 (2004) 413–424.

[۱۰] ا. شیرانی، م. ح. علامت ساز. محاسبه ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمههای نقطهای در آب و سرب، مجله پژوهش فیزیک ایران. ۱ (۱۳۸۰).

[11] L. Auditore, R.C. Barna, D.De Pasquale, A. Italiano, A. Trifiro, M. Trimarchi. Study of a 5 MeV electron linac based neutron source. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 229 (2005) 137-143.

- [12] Y.S. Kim, Z. Khazaei, J. Ko, H. Afarideh, M. Ghergherechi. Estimation of photoneutron yield in linear accelerator with different collimation systems by Geant4 and MCNPX simulation codes, Phys. Med. Biol. 61 (2016) 2762–2779.
- [13] B. Askri. Optimization of a photoneutron source based on 10 MeV electron beam using Geant4 Monte Carlo code. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 360 (2015) 1–8.
- [14] D.B. Pelowitz. MCNPX User's Manual. LA-CP-07-1473, ORNL/RSICC, (2008).
- [15] A.B. Chilton, J.K. Shultis, R.E. Faw. Principles of Radiation Shielding. Prentice Hall, London, (1984).
- [16] R.D. Evans. The Atomic Nucleus. McGraw-Hill Publishing Company, New Delhi, (1955).
- [17] H. Cember, T.E. Johnson. Introduction to Health Physics, McGraw-Hill, New York, (2009).
- [18] XCOM. National Institute of Standards and Technology.
- [19] H. Hirayama. Calculation of gamma-ray exposure buildup factors up to 40mfp using the EGS4 Monte Carlo code with a particle splitting. J .Nucl. Sci. Technol. 12 (1995) 1201–1207.
- [20] H. Atak, O. Şahin Çelikten, M. Tombakoğlu. Finite and infinite system gamma ray buildup factor calculations with detailed physics. Appl. Radiat. Isot. 105 (2015) 11–14.
- [21] Y. Harima, Y. Sakamoto, S. Tanaka and M. Kawai. Validity of the geometric-progression formula in approximating gamma-ray buildup factors. Nucl. Sci. Eng. 94 (1986) 24–35.
- [22] M.M. Rafiei and H. Tavakoli-Anbaran. Calculation of the exposure buildup factors for xray photons with continuous energy spectrum using Monte Carlo code. J. Radiol. Prot. 38 (2018) 207–217.